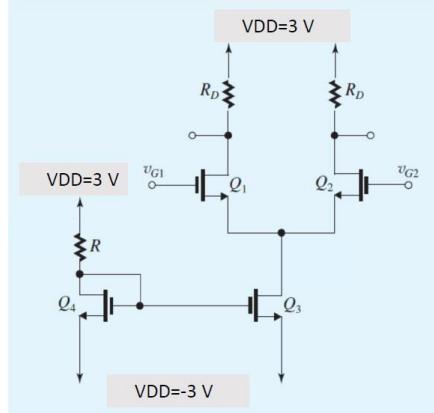


## Terza esercitazione Spice

### Amplificatore differenziale con generatore di corrente



#### 1) Punto di lavoro dei transistor

Dati:  $V_t = 0.5$ ,  $k'_n = 200 \mu A/V^2$ ,  $\lambda = 0$ ,  $\left(\frac{W}{L}\right)_3 = \left(\frac{W}{L}\right)_4 = 5$ ,  $\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 20$ ,  $R_D = 20 k\Omega$   
 $R = 1114017 * \frac{30}{1000} = 33420.51 \Omega$

#### Transistor $Q_4$ :

- $$\begin{cases} V_{GSQ4} = V_{DSQ4} = V_{D4} - V_{S4} = V_{DD} - R * I_{DQ4} - V_{SS} \\ I_{DQ4} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_4 (V_{GSQ4} - V_t)^2 \end{cases}$$
 $\Rightarrow I_{DQ4} = 1.483 * 10^{-4} A \Rightarrow V_{GSQ4} = V_{DSQ4} = 1.04 V$  che è  $> V_t \Rightarrow ok$   
 $\Rightarrow I_{DQ4} = 1.827 * 10^{-4} A \Rightarrow V_{GSQ4} = V_{DSQ4} = -0.1 V$  che è  $< V_t \Rightarrow no$
- $V_{GDQ4} = 0$  che è  $< V_t \Rightarrow$  soddisfa le condizioni di saturazione

#### Transistor $Q_3$ :

- $V_{GSQ3} = V_{GSQ4} = 1.04 V$
- $I_{DQ3} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{GSQ3} - V_t)^2 = 1.483 * 10^{-4} A$

Notiamo che  $I_{DQ3} = I_{DQ4}$  perché i transistor dello specchio di corrente sono identici.

#### Transistor $Q_1$ e $Q_2$ :

- Siccome sono simmetrici possiamo considerare sole metà circuito.
- $I_{DQ1} = I_{DQ2} = \frac{I_{DQ3}}{2} = 7.415 * 10^{-5} A$
- $I_{DQ1} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GSQ1} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GSQ1} = V_{GSQ2} = \sqrt{\frac{2I_{DQ1}}{k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_1}} + V_t = 0.69 V$   
 che è  $> V_t \Rightarrow ok$
- $V_{GDQ1} = V_{GDQ2} = -(V_{DD} - R_D * I_{DQ1}) = -1.57 V$  che è  $< V_t \Rightarrow$  soddisfa la saturazione
- $V_{SQ1} = V_{SQ2} = V_{DQ3} = V_{GQ1} - V_{GSQ1} = -V_{GSQ1} = -0.69 V$
- $V_{DSQ1} = V_{DSQ2} = V_{DD} - R_D * I_{DQ1} - V_{SQ1} = -0.88 V$

$$V_{DSQ3} = V_{DQ3} - V_{SQ3} = V_{SQ1} - V_{SS} = 2.31 V$$

## 2) Calcolo $g_m$

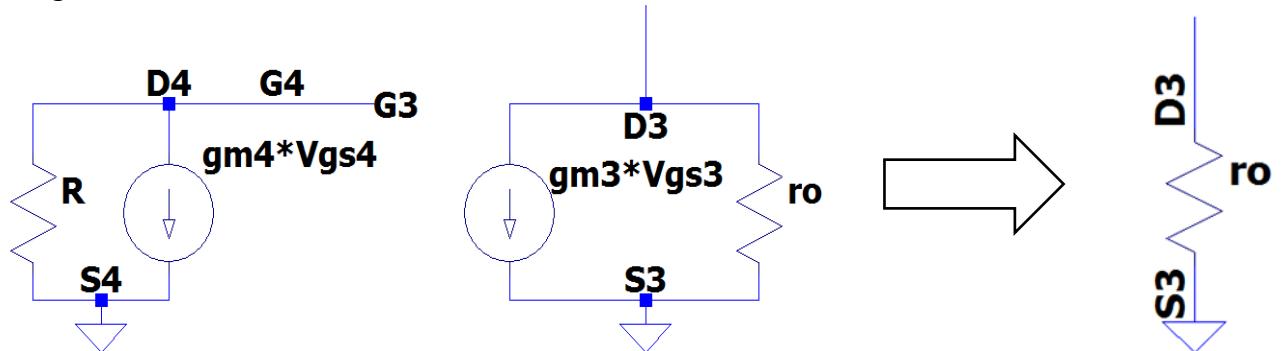
Siccome  $Q_1$  e  $Q_2$  sono simmetrici:  $g_m = g_{m1} = g_{m2} = k'_n \left( \frac{W}{L} \right)_1 (V_{GSQ1} - V_t) = 7.6 * 10^{-4}$

## 3) $\lambda_{Q3} = 0.02$ e Piccolo segnale per lo specchio di corrente

Abbiamo quindi:

- $r_o = \frac{1}{\lambda I_{DQ3}} = 337 \text{ k}\Omega$
- $v_{gsq4} = -g_{m4} v_{gsq4} \Rightarrow v_{g4} = v_{g3} = 0 \Rightarrow v_{gsq3} = 0$

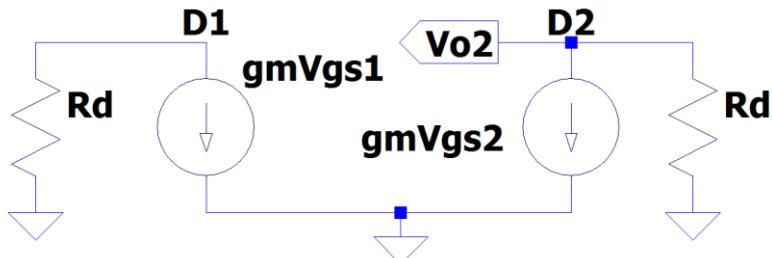
Quindi lo specchio di corrente nel piccolo segnale viene rappresentato dalla singola resistenza  $r_o$  collegata a massa.



## 4) Guadagno differenziale single ended

Piccolo segnale:

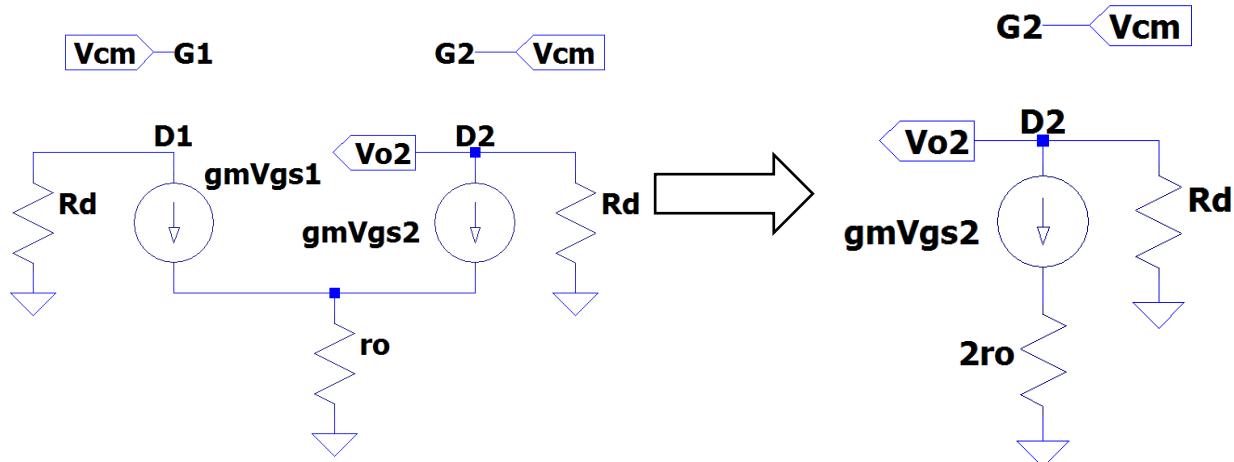
$$G1: +V_{id}/2 \quad G2: -V_{id}/2$$



- $v_{o2} = -g_m v_{gs2} R_D = g_m R_D v_{id}/2$
- $A_d = \frac{v_{o2}}{v_{id}} = \frac{g_m R_D}{2} = 7.6 \text{ V/V}$

## 5) Guadagno di modo comune single ended

Piccolo segnale:



Siccome i circuiti sono simmetrici posso considerare solo metà.

- $v_{gs2} = \frac{v_{cm}}{1+2r_0g_m}$
- $v_{o2} = -R_D g_m v_{gs2} = -R_D g_m \frac{v_{cm}}{1+2r_0g_m}$
- $A_{cm} = \frac{v_{o2}}{v_{cm}} = \frac{-R_D g_m}{1+2r_0g_m} = -0.0296 V/V$

## 6) Massima tensione $V_{CM}$

La massima tensione si ottiene ponendo il transistor al limite della saturazione, quindi

$$V_{CM} = V_D + V_t = V_{DD} - R_D I_{DSQ1} + V_t = 2.017 V$$

## 7) $A_{cm}$ con $\lambda_{Q3} = 0$

- $r_o = \frac{1}{\lambda I_{DQ3}} = +\infty$
- $A_{cm} = \frac{v_{o2}}{v_{cm}} = \frac{-R_D g_m}{1+2r_0g_m} = 0 V/V$

## 8) Simulazione Spice

Listato:

```

M1 vo1 Vin1 Vs Vs NMOS L=1 W=20
M2 vo2 Vin2 Vs Vs NMOS L=1 W=20
M3 Vs Vg2 VSS VSS NMOS L=1 W=5
M4 Vg2 Vg2 VSS VSS NMOS L=1 W=5
R1 VDD vo1 20K
R2 VDD vo2 20K
R3 VDD Vg2 33.42K
Vg1 Vin1 0 DC 0 AC 10mV sin(0 10mV 10khz 0 0 0)
Vg2 0 Vin2 DC 0 AC 10mV sin(0 10mV 10khz 0 0 0)
VSS VSS 0 -3V
VDD VDD 0 3V
.model NMOS NMOS VTO=0.5 KP=200u LAMBDA=0
.TRAN 0u 250u 0 1u
#.op
.backanno
.end

```

La verifica del punto operativo in dc conferma tutti i calcoli fatti precedentemente:

--- Operating Point ---

```
V(vo1) :      1.51723      voltage
V(vin1) :      0      voltage
V(vs) :     -0.692534      voltage
V(vo2) :      1.51723      voltage
V(vin2) :      0      voltage
V(vg2) :     -1.95543      voltage
V(vss) :      -3      voltage
V(vdd) :       3      voltage
Id(M4) :    0.000148277      device_current
Ig(M4) :      0      device_current
Ib(M4) :   -1.05457e-012      device_current
Is(M4) :  -0.000148277      device_current
Id(M3) :    0.000148277      device_current
Ig(M3) :      0      device_current
Ib(M3) :   -2.31747e-012      device_current
Is(M3) :  -0.000148277      device_current
Id(M2) :   7.41387e-005      device_current
Ig(M2) :      0      device_current
Ib(M2) :   -2.21976e-012      device_current
Is(M2) :  -7.41387e-005      device_current
Id(M1) :   7.41387e-005      device_current
Ig(M1) :      0      device_current
Ib(M1) :   -2.21976e-012      device_current
Is(M1) :  -7.41387e-005      device_current
I(R3) :    0.000148277      device_current
I(R2) :   7.41387e-005      device_current
I(R1) :   7.41387e-005      device_current
I(Vdd) :  -0.000296555      device_current
I(Vss) :   0.000296555      device_current
I(Vg2) :      0      device_current
I(Vg1) :      0      device_current
```

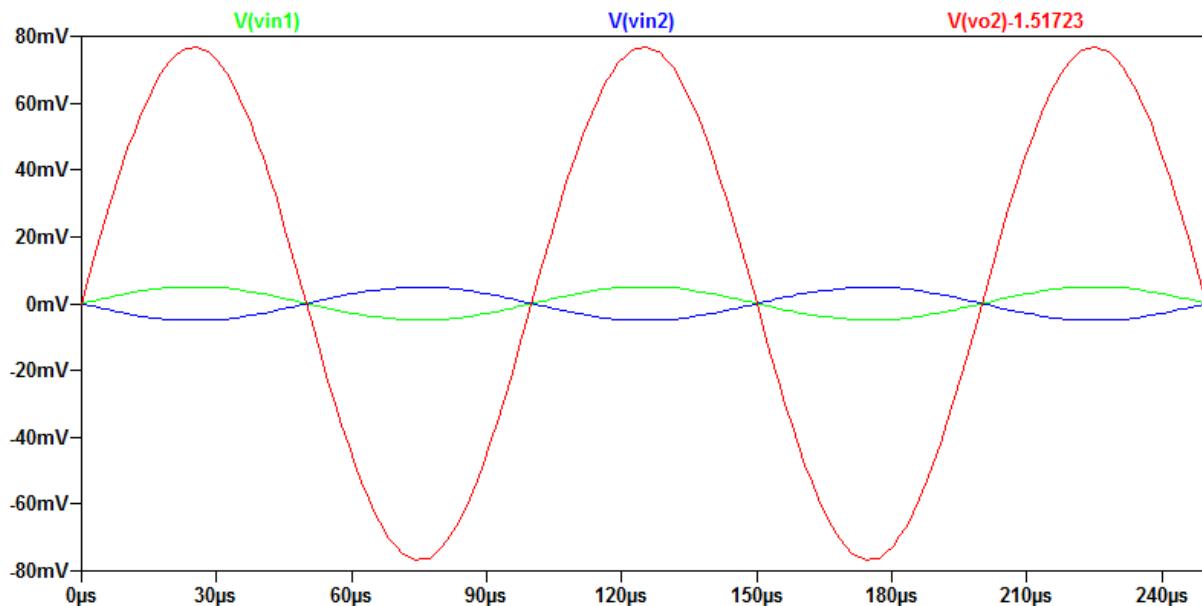
Per la seguente simulazione si è dato come ingresso  $v_{id} = 10mV$ , quindi  $\pm \frac{v_{id}}{2} = 5mV$ :

Vg1 Vin1 0 DC 0 AC 5mV sin(0 5mV 10khz 0 0 0)

Vg2 0 Vin2 DC 0 AC 5mV sin(0 5mV 10khz 0 0 0)

e si è usato il comando

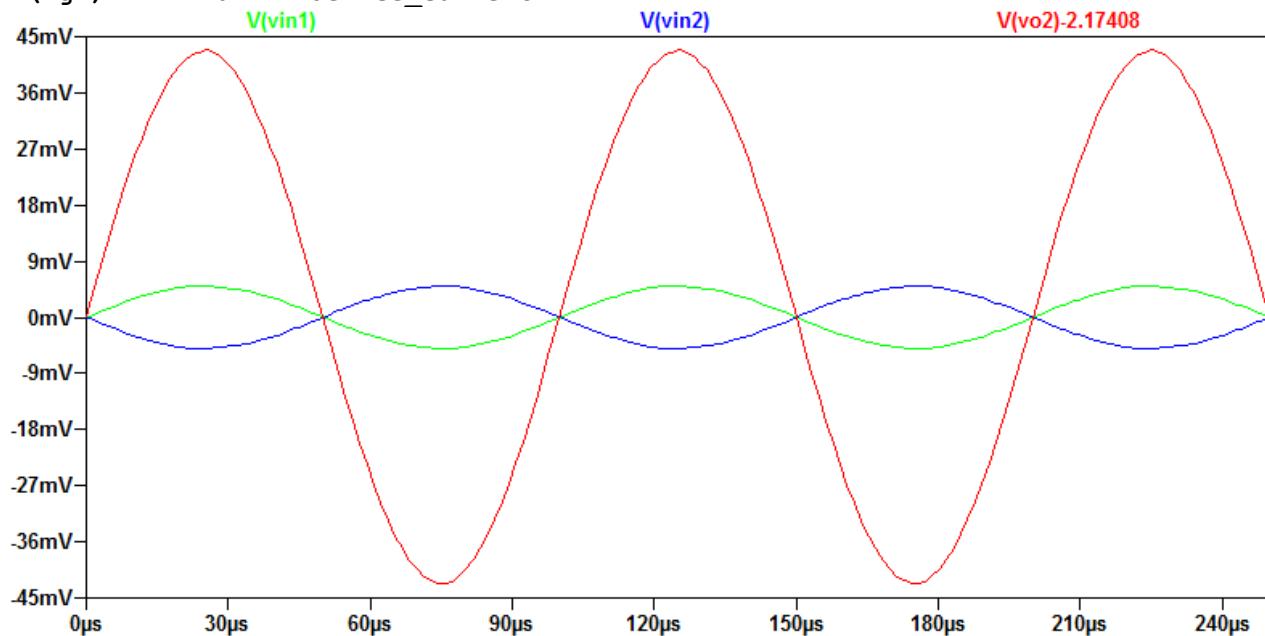
.TRAN 0u 250u 0 1u



$$9) \text{ Con } R_D = \frac{111417}{100}$$

--- Operating Point ---

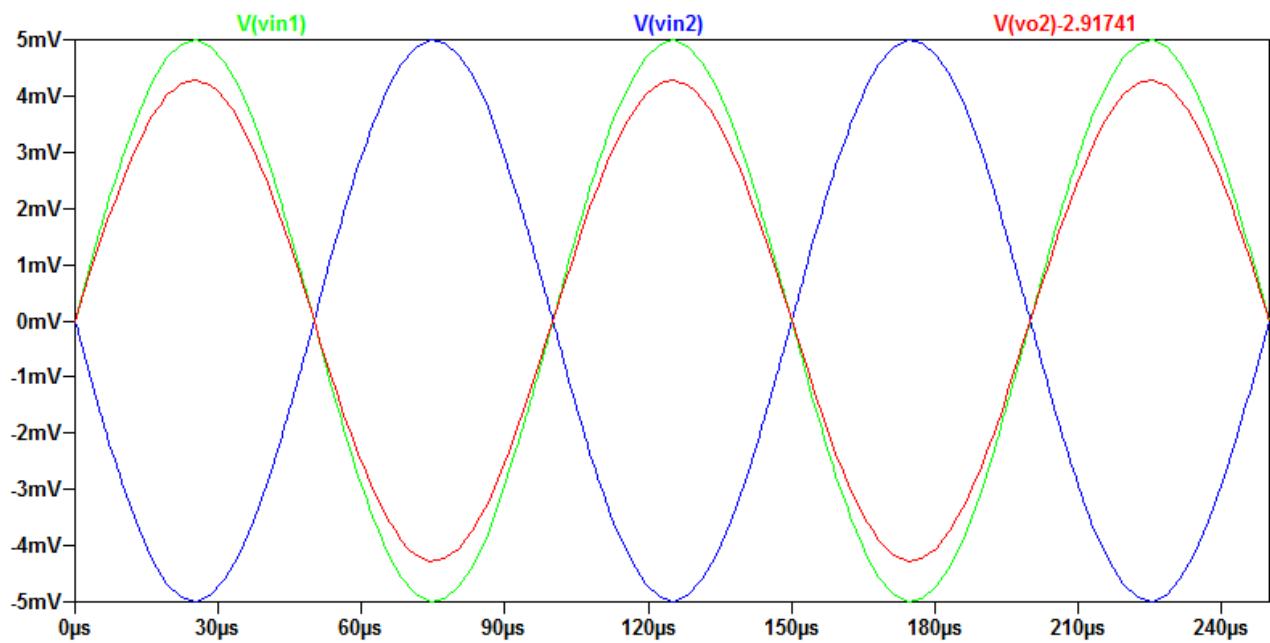
```
V(vo1) : 2.17408      voltage
V(vin1) : 0            voltage
V(vs) : -0.692534    voltage
V(vo2) : 2.17408      voltage
V(vin2) : 0            voltage
V(vg2) : -1.95543    voltage
V(vss) : -3           voltage
V(vdd) : 3            voltage
Id(M4) : 0.000148277 device_current
Ig(M4) : 0            device_current
Ib(M4) : -1.05457e-012 device_current
Is(M4) : -0.000148277 device_current
Id(M3) : 0.000148277 device_current
Ig(M3) : 0            device_current
Ib(M3) : -2.31747e-012 device_current
Is(M3) : -0.000148277 device_current
Id(M2) : 7.41387e-005 device_current
Ig(M2) : 0            device_current
Ib(M2) : -2.87662e-012 device_current
Is(M2) : -7.41387e-005 device_current
Id(M1) : 7.41387e-005 device_current
Ig(M1) : 0            device_current
Ib(M1) : -2.87662e-012 device_current
Is(M1) : -7.41387e-005 device_current
I(R3) : 0.000148277 device_current
I(R2) : 7.41387e-005 device_current
I(R1) : 7.41387e-005 device_current
I(Vdd) : -0.000296555 device_current
I(Vss) : 0.000296555 device_current
I(Vg2) : 0            device_current
I(Vg1) : 0            device_current
```



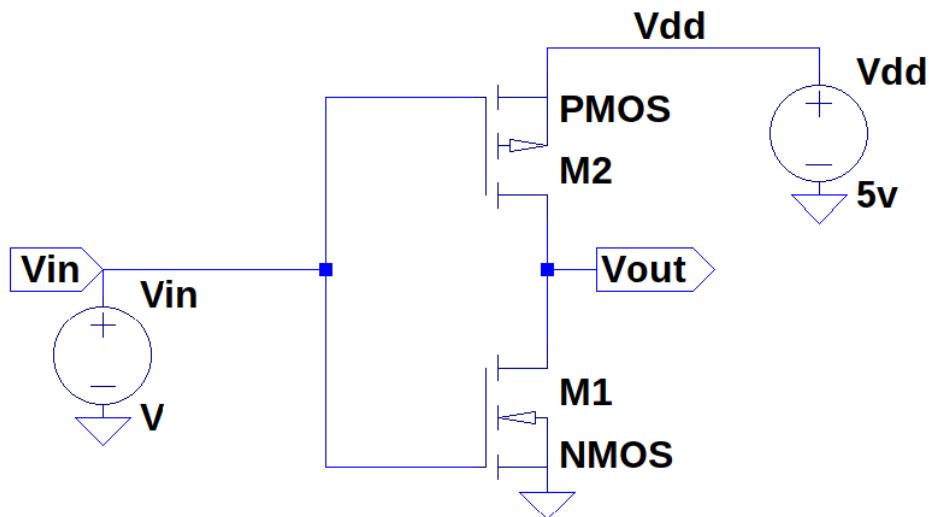
$$\text{Con } R_D = \frac{111417}{1000}$$

--- Operating Point ---

V(vo1) :	2.91741	voltage
V(vin1) :	0	voltage
V(vs) :	-0.692534	voltage
V(vo2) :	2.91741	voltage
V(vin2) :	0	voltage
V(vg2) :	-1.95543	voltage
V(vss) :	-3	voltage
V(vdd) :	3	voltage
Id(M4) :	0.000148277	device_current
Ig(M4) :	0	device_current
Ib(M4) :	-1.05457e-012	device_current
Is(M4) :	-0.000148277	device_current
Id(M3) :	0.000148277	device_current
Ig(M3) :	0	device_current
Ib(M3) :	-2.31747e-012	device_current
Is(M3) :	-0.000148277	device_current
Id(M2) :	7.41387e-005	device_current
Ig(M2) :	0	device_current
Ib(M2) :	-3.61994e-012	device_current
Is(M2) :	-7.41387e-005	device_current
Id(M1) :	7.41387e-005	device_current
Ig(M1) :	0	device_current
Ib(M1) :	-3.61994e-012	device_current
Is(M1) :	-7.41387e-005	device_current
I(R3) :	0.000148277	device_current
I(R2) :	7.41387e-005	device_current
I(R1) :	7.41387e-005	device_current
I(Vdd) :	-0.000296555	device_current
I(Vss) :	0.000296555	device_current
I(Vg2) :	0	device_current
I(Vg1) :	0	device_current



## Inverter CMOS



Dati:  $V_{DD} = 5V$ ,  $V_{tn} = -V_{tp} = 0.7 V$ ,  $k'_n = 48\mu A/V^2$ ,  $k'_p = 12\mu A/V^2$ ,  $\lambda = 0.01$ ,  $L = 1\mu m$

### 1) Calcolo $W_p$ e $W_n$

- $k_n = k_p \Rightarrow k'_n C_{ox} W_n / L = k'_p C_{ox} W_p / L \Rightarrow \frac{W_p}{W_n} = 4$
- Scelgo  $W_n = L = 1 \mu m \Rightarrow W_p = 4 \mu m$

### 2) Simulazione spice Vo/Vi con Vi=0-5

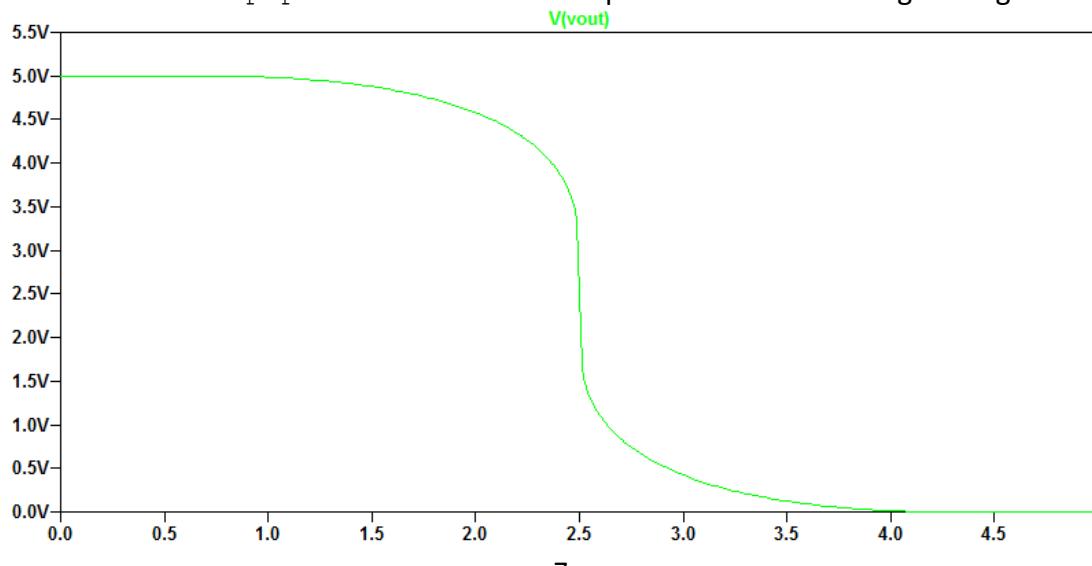
Listato:

```

M1 Vout Vin 0 0 NMOS L=1u W=1u
M2 Vout Vin Vdd Vdd PMOS L=1u W=4u
Vin Vin 0 {Vin}
Vdd Vdd 0 5v
.model NMOS NMOS VTO=0.7v KP=48u LAMBDA=0.01
.model PMOS PMOS VTO=-0.7v KP=12u LAMBDA=0.01
.step param Vin 0 5 0.01
.backanno
.end

```

Usando il comando `.step param Vin 0 5 0.01` possiamo ricavare il seguente grafico:



### 3) Simulazione con Onda quadra 1MHz

Possiamo dare in ingresso un'onda quadra grazie al comando

Vin Vin 0 pulse(0 5 0 0 0 0.5u 1u)

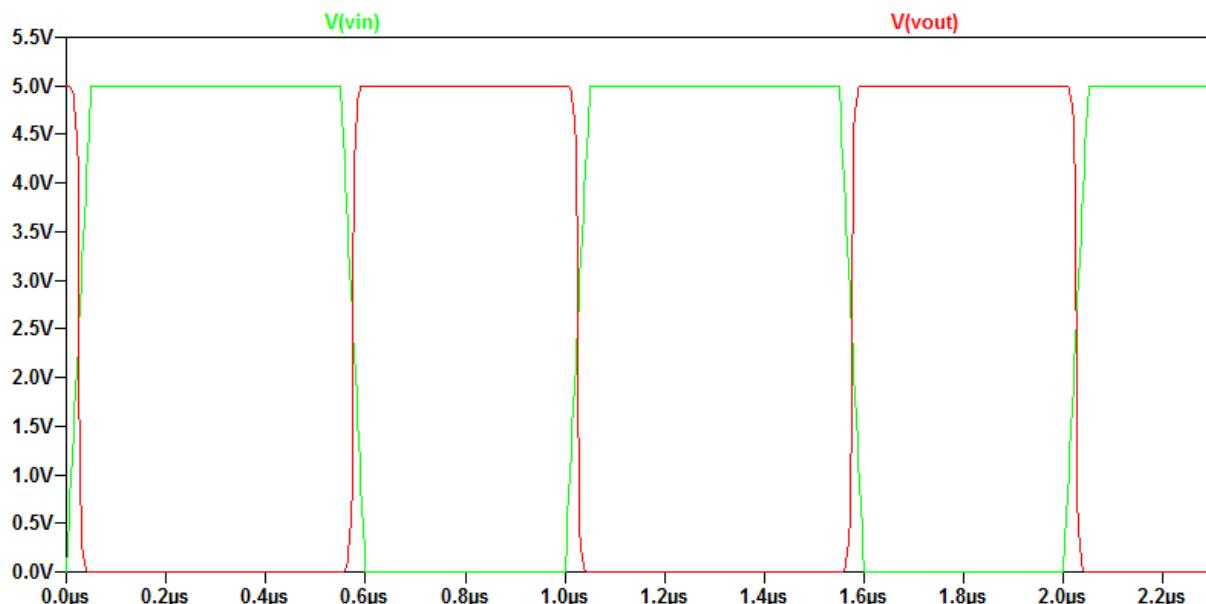
E vederne l'effetto grazie a: .tran 0 5u 0

I quali parametri sono:

- Vmin
- Vmax
- Delay,tempo di salita, tempo di discesa
- Tempo on
- Periodo

Dato che siamo in cerca di una sinusoide con duty-cycle del 50% a 1MHz si sono settati i parametri di conseguenza.

```
M1 Vout Vin 0 0 NMOS L=1u W=1u
M2 Vout Vin Vdd Vdd PMOS L=1u W=4u
Vin Vin 0 pulse(0 5 0 0 0 0.5u 1u)
Vdd Vdd 0 5v
.model NMOS NMOS VTO=0.7v KP=48u LAMBDA=0.01
.model PMOS PMOS VTO=-0.7v KP=12u LAMBDA=0.01
.tran 0 2.3u 0
.op
.backanno
.end
```



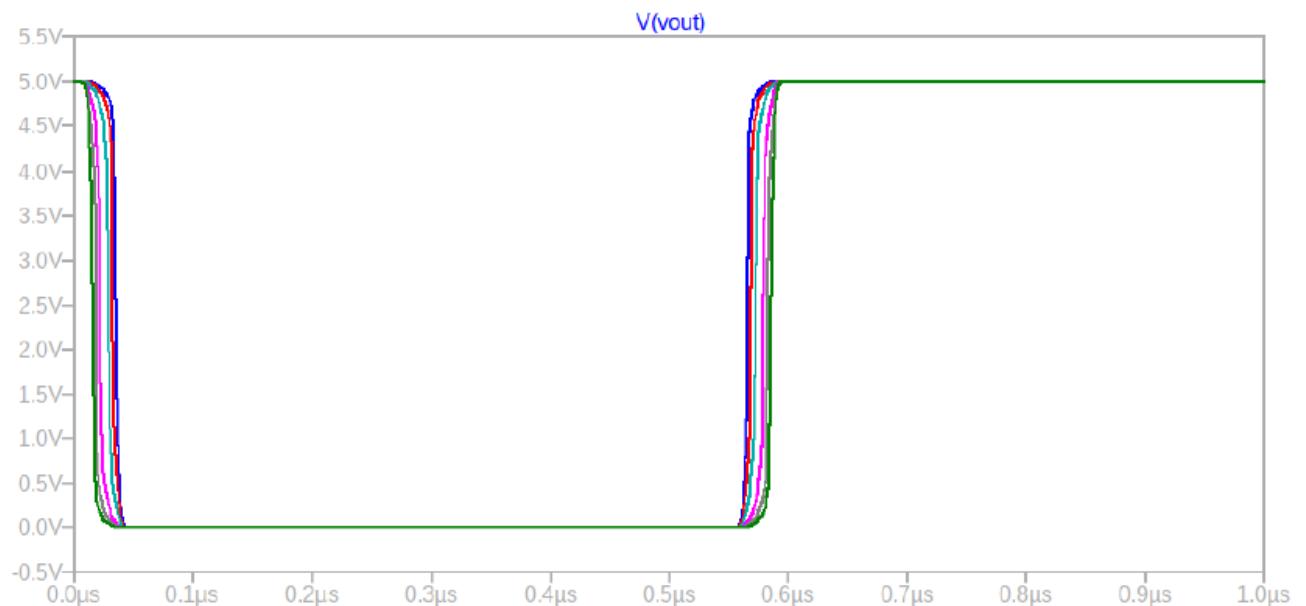
#### 4) Analisi al variare delle proporzioni del transistor NMOS

Grazie al comando `.step param WN list 1u 2u 5u 20u 50u 100u` possiamo far variare selettivamente un parametro tra quelli inseriti in una lista predefinita. Lasciando il transistor PMOS invariato, e modificando l'NMOS come segue: `M1 Vout Vin 0 0 NMOS L=10u W=WN` sarà possibile ricavare il seguente grafico:

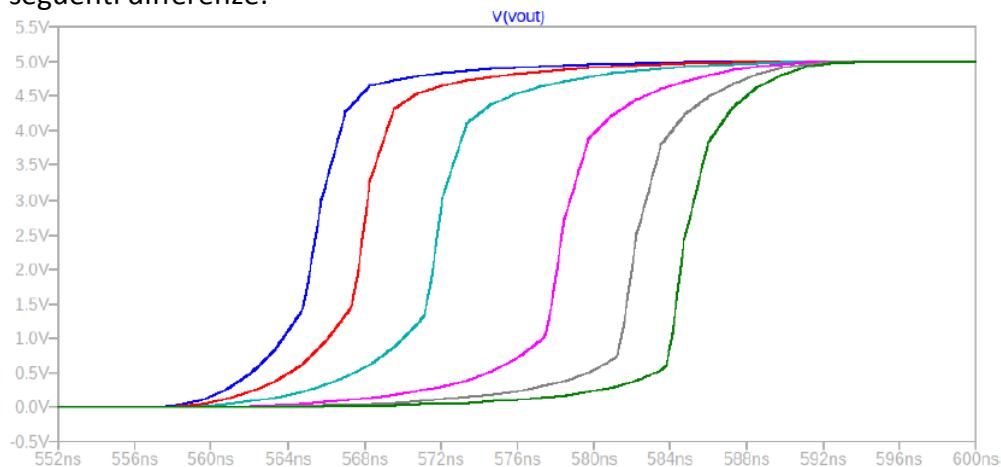
```

M1 Vout Vin 0 0 NMOS L=10u W=WN
M2 Vout Vin Vdd Vdd PMOS L=1u W=4u
Vin Vin 0 pulse(0 5 0 0 0 0.5u 1u)
Vdd Vdd 0 5v
.model NMOS NMOS VTO=0.7v KP=48u LAMBDA=0.01
.model PMOS PMOS VTO=-0.7v KP=12u LAMBDA=0.01
.tran 0 1.3u 0
.step param WN list 1u 2u 5u 20u 50u 100u
.op
.backanno
.end

```



Facendo un ingrandimento nella zona in cui l'onda quadra commuta potremo osservare le seguenti differenze:



Per quanto riguarda le diverse funzioni di trasferimento al variare delle proporzioni si ricava il seguente grafico:

